

## 先端 I C T デバイス ラボ 施設 外部 利用 約 款

### (適用範囲)

第 1 条 本約款は、国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」という。）の研究施設、研究設備及び研究機器（これらを利用するのに不可欠なデータ、データベース及びソフトウェアを含む。以下「施設等」という。）のうち、先端 I C T デバイス ラボ 施設の施設等を機構以外の機関（以下「外部機関」という。）に利用（以下「外部利用」という。）させる場合に適用します。ただし、共同研究契約その他の契約等に基づき外部利用させる場合は除きます。

### (対象施設等の構成)

第 2 条 外部利用に供する対象施設等である先端 I C T デバイス ラボ 施設の施設等の構成は、外部利用に係るデバイス製造プロセスモデルごとに定めるものとし、別表のとおりとします。

### (利用形態)

第 3 条 外部利用の利用形態は、以下のいずれかとします。

#### 一 研究連携型

機構が行う研究開発及び施設等の運用に寄与する利用形態をいいます。

#### 二 成果活用・施設等供用型

機構の業務に係る成果の普及に資する利用形態又は機構の施設等の有効な活用のために外部機関に供用する利用形態をいいます。

2 研究連携型の外部利用については、外部利用を希望する外部機関が、次の各号に掲げる全ての事項に同意することを条件とします。

一 外部利用により得られた施設等の機能・性能の評価に資する実験データ又は外部利用による効果を評価した結果を示す報告書を提供すること及びこれらを機構が無償で利用すること。

二 外部利用終了後、速やかに第 1 9 条に規定する成果報告書を提出すること。

3 成果活用・施設等供用型の外部利用については、外部利用を希望する外部機関が、次の各号に掲げる全ての事項に同意することを条件とします。

一 外部利用終了後、速やかに第 1 8 条に規定する外部利用終了報告書を提出すること。

二 以下に関する記載を外部利用終了報告書に含めること。

(1) 外部利用の成果の取扱い及び公開予定の有無

(2) 外部利用の目的の達成度

(外部利用に関する事前相談)

第 4 条 外部利用を希望する外部機関は、次条の規定に基づく外部利用の申請を行う前に、機構に対して外部利用の内容につき事前相談を行うものとし、機構は、その結果に基づき、当該外部利用の可否を判断するものとし、

### (外部利用の申請)

第 5 条 外部利用を希望する外部機関は、別紙様式第 1 「外部利用申請書」に別紙様式第

2 「外部利用計画書」を添え、外部利用の申請を行うものとします。

(外部利用の許可)

第6条 機構は、前条の規定により外部利用の申請をした外部機関（以下「外部利用申請者」という。）の申請の内容が、審査の結果、次の各号に掲げる事項の全てを満たすと認められる場合、当該外部利用を許可することができるものとし、許可した場合には、当該外部利用申請者に別紙様式第3「外部利用許可通知書」により通知します。これにより、当該外部利用申請者は、外部利用を許可された外部機関（以下「外部利用者」という。）となります。

- 一 当該申請に係る外部利用が機構の研究業務遂行上支障のないものであること。
- 二 当該申請に係る外部利用に供する施設等を当該申請に係る外部機関以外の者に外部利用させるものでないこと。
- 三 当該申請に係る外部利用の目的が、研究開発、社会実証又は機構の業務に係る成果の普及と無関係ではないこと。
- 四 公序良俗に反するおそれがないこと。
- 五 機構の安全保障輸出管理規程に基づいた確認がされていること。
- 六 第23条第1項に規定する協議が必要な場合、当該協議の結果、合意に達したこと。
- 七 その他本約款にて定める事項を満たすこと。

2 前項各号に掲げる事項のほか、機構は、前条の規定による申請の内容が、先端ICTデバイ斯拉ボ施設の施設等を破損若しくは滅失等させ、又は管理運営上支障をきたすおそれがあると判断した場合には、外部利用を許可しないものとします。

3 第1項の許可は、機構における施設等の管理運営上必要な条件を付し、又は外部利用日を変更する等、申請の内容を変更する場合があります。

4 機構は、第1項の許可の後、機構における施設等の管理運営上、当該許可に係る外部利用日の一部又は全部を他の日に振り替える場合があります。

5 外部利用者は、外部利用を開始する前に、別紙様式第4「利用規則の概要及び同意書」の利用規則の概要を確認し、同意書に必要な事項を記入した上で、機構の先端ICTデバイ斯拉ボ長に提出するものとします。

(機器等の持ち込み)

第7条 外部利用申請者は、外部利用に当たり必要な実験機器、情報通信機器（パーソナルコンピュータ、携帯端末等）、化学物質等（以下「機器等」という。）の持ち込みを希望する場合には、次の各号に従うことを条件として、別紙様式第1「外部利用申請書」に持ち込み機器等の有無を、別紙様式第2「外部利用計画書」に持ち込み機器等の詳細を記載の上、第5条の申請を行うものとします。

- 一 持ち込む機器等は、許可を受けたものに限ること。
- 二 持ち込む機器等に必要な消耗品は、外部利用者において用意すること。
- 三 持ち込む機器等は、機構の施設等と明確に区別できるよう必要な措置をとること。
- 四 持ち込む機器等の保守等は、外部利用者の責任において行うこと。
- 五 持ち込む機器等の管理、破損、盗難等の責任は、外部利用者の責任とすること。

2 先端ICTデバイ斯拉ボ施設で着用するクリーンウェアは、機構が貸与するものとします。

- 3 外部利用者は、記録媒体（ハードディスク、USBメモリ、カメラ等）の持ち込みをしてはならないものとし、必要がある場合には、機構が記録媒体を貸与するものとします。
- 4 外部利用者は、持ち込みの許可を受けた機器等を、機構の情報通信ネットワーク、情報通信機器、実験機器等を含む機構のいかなる施設、設備、機器等にも接続しないものとし、かつ、これらを破損又は滅失等させないように使用するものとします。  
(外部利用の許可の取消し等)

第8条 機構は、外部利用者について、第6条第1項の各号に掲げる事項のいずれかに違反した場合若しくは次の各号に掲げる事項のいずれかに該当した場合又は申請の内容が虚偽であることが判明した場合には、当該外部利用の許可を取り消し、又は当該外部利用を中止させることができるものとします。

- 一 正当な理由なく、相当の期間、外部利用の許可を受けた施設等を利用しない場合
- 二 正当な理由なく、頻繁に外部利用期間の変更、外部利用予定日の取消し又は変更等を行い、管理運営上支障をきたすと認められる場合
- 三 著作権その他の第三者の権利を侵害するおそれがあると認められる場合
- 四 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる場合
- 五 外部利用負担金その他外部利用者が負担する債務の支払いを遅滞し、又は拒否した場合
- 六 外部利用者について第28条の規定に反する事実が判明した場合
- 七 外部利用に当たり機構が指示する事項に従わない場合
- 八 先端ICTデバイスラボ施設の施設等の品質及び運用に著しい悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合
- 九 その他本約款の各条項に違反した場合

2 機構は、前項の規定によるほか、管理運営上支障があると認められる場合には、当該外部利用の許可を取り消し、又は当該外部利用を中止させることができるものとします。  
(外部利用が可能な期間及び時間)

第9条 外部利用は、許可を受けた外部利用の日又は期間で行うものとします。なお、外部利用ができるのは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日までを除いた日とし、原則として、午前8時30分から午後5時00分までの時間とします。  
(外部利用の内容変更及び取りやめ)

第10条 外部利用者は、機構が第6条第1項の規定に基づき別紙様式3「外部利用許可通知書」により通知したとおりに外部利用するものとし、外部利用の内容変更を希望する場合は、次の各号に掲げるとおり機構に申請を行い、許可を受けるものとします。ただし、外部利用に及ぼす影響が小さい軽微な変更等については、この限りではありません。

- 一 外部利用許可通知書の「1. 外部利用を行う場所」、「2. デバイス製造プロセスモデル」、「3. 外部利用を行う機関名」、「4. 外部利用の目的」又は「5. 利用形態」を変更する場合は、第5条の規定に基づき新規に機構に対して外部利用の申請を行い、許可を受けるものとします。

二 外部利用許可通知書の「6. 外部利用の日又は期間」又は「8. 外部利用の人数」を変更する場合は、別紙様式第5「外部利用の内容変更・取りやめ申請書」により、機構に申請を行い、許可を受けるものとします。

三 外部利用許可通知書の「7. 持ち込み実験機器、情報通信機器、化学物質等の名称、数量、利用目的、消費電力等」を変更する場合は、別紙様式第5「外部利用の内容変更・取りやめ申請書」の「4. 外部利用計画書の変更項目」にその旨を記載の上、修正した外部利用計画書とともに提出し、機構に申請を行い、許可を受けるものとします。

四 前三号に掲げるものを除く事項については、機構に申し出るものとします。

2 外部利用者は、第5条に規定する外部利用の申請時に提出した別紙様式第2「外部利用計画書」の内容変更を希望する場合は、次の各号に掲げるとおり対応するものとします。

一 外部利用計画書の「1. 計画名」、「2. 外部利用で行う実験内容の詳細」、「4. 外部利用者の構成員一覧」、「6. 機構が行う研究開発及び施設等の運用への寄与内容（研究連携型の場合のみ）」又は「7. 今後の情報通信研究機構との共同研究契約の予定」を変更する場合は、別紙様式第5「外部利用の内容変更・取りやめ申請書」の「4. 外部利用計画書の変更項目」にその旨を記載の上、修正した外部利用計画書とともに提出し、機構に申請を行い、許可を受けるものとします。

二 外部利用計画書の「計画担当者」、「所属機関」又は「8. 今後の外部利用のスケジュール」を変更する場合は、外部利用計画書を修正の上、機構に再提出するものとします。

3 外部利用者は、外部利用を取りやめようとするときも、別紙様式第5「外部利用の内容変更・取りやめ申請書」により、機構に申請を行い、許可を受けるものとします。

4 機構は、前三項の申請及び申出について管理運営上支障がないと認められる場合には、これを許可することができるものとし、許可した場合には、第6条第1項の規定に準じて当該外部利用者に書面により通知します。

(外部利用の休止及び制約)

第11条 機構は、管理運営上その他の事情によりやむを得ないときは、外部利用を休止することがあります。

2 外部利用者は、管理運営上の理由で外部利用に制約が生じる場合又は外部利用ができない場合があります。

(入構及び入退室手続)

第12条 外部利用者は、機構の入構に際しては機構の指示に従うものとし、指示された施設等以外の場所に無断で立ち入ることはできないものとします。

2 外部利用者は、外部利用の許可を受けた施設等への入退室及びこれらを利用する際には、機構が発行する「外部利用許可通知書」を提示可能な状態としておくものとし、機構はこれにより確認を行います。

(講習の受講)

第13条 外部利用者は、先端ICTデバイスラボ施設の施設等の外部利用を開始する前に、先端ICTデバイスラボが実施する外部利用に関する講習を受講するものとします。

2 先端 I C T デバイスラボ施設の施設等を前年度から継続して外部利用する場合は、先端 I C T デバイスラボが実施する年に 2 回の継続利用者講習のうち、いずれか 1 回を受講するものとします。

3 前二項に規定する講習は、先端 I C T デバイスラボにおける受講又は通信教育による受講のいずれかを選択できるものとします。

(外部利用負担金)

第 1 4 条 外部利用負担金は、別表に掲げる基本単価及び次条の規定により減額後の単価に基づき算定します。

(外部利用負担金の減額)

第 1 5 条 次の各号に掲げる外部利用者については、別表に掲げる基本単価より 5 0 % を減額した値から算定するものとし、減額した単価は、別表の「第 1 5 条第 1 項又は第 2 項の規定による減額後の単価」のとおりとします。

一 地方公共団体

二 学校教育法（昭和 2 2 年法律第 2 6 号）第 1 条、第 1 2 4 条及び第 1 3 4 条に掲げる学校

三 中小企業基本法（昭和 3 8 年法律第 1 5 4 号）第 2 条に掲げる中小企業者

四 その他前各号に準ずる機関又は団体で機構が適当と認める者

2 研究連携型の外部利用については、次の各号に掲げるとおり減額を行うものとし、減額した単価は、第 1 号の場合は別表の「第 1 5 条第 1 項又は第 2 項の規定による減額後の単価」のとおり、第 2 号の場合は別表の「第 1 5 条第 1 項及び第 2 項の規定による減額後の単価」のとおりとします。

一 別表に掲げる基本単価より 5 0 % を減額した値から算定

二 前項各号に掲げる外部利用者にあつては、前項の規定により 5 0 % を減額した上で、前号の規定により減額した値から算定

(外部利用負担金の請求及び納付)

第 1 6 条 機構は、別紙様式第 6 「請求書」に基づき、外部利用負担金の額、納付期限、機構が指定する振り込み先の金融機関の口座等を明示した請求書を発行し、外部利用者に対して、納付期限までに納付すべき全額の納付を求めるとします。

2 外部利用者は、前項の納付期限までに前項の外部利用負担金の全額を支払うものとします。納付に係る費用は、外部利用者の負担とします。

3 機構は、第 1 項の規定により納付された外部利用負担金について、当該外部利用者に返還しないものとします。ただし、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当した場合には、機構と当該外部利用者との間で協議の上、外部利用負担金の全部又は一部を当該外部利用者へ返還します。

一 第 8 条第 2 項の規定により機構が外部利用の許可を取り消した場合又は当該外部利用を中止させた場合

二 天災等のやむを得ない事情により外部利用が不可能になった場合

(延滞金)

第 1 7 条 機構は、前条第 1 項の納付期限までに外部利用者が外部利用負担金の支払いを行わなかったときは、納付期限の翌日から納付した日までの期間について、国の債権の

管理等に関する法律施行令（昭和31年政令第337号）第29条本文に定める率により算定した金額を外部利用者から延滞金として徴収するものとします。ただし、当該納付期限までに支払いを行わなかったことについて、特別の事情があり、かつ、機構がやむを得ないと認めた場合にあっては、この限りではありません。

- 2 前項の規定により算定した延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金を支払うことを要せず、また、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。

（外部利用終了の報告）

第18条 成果活用・施設等供用型の外部利用者は、外部利用終了後、速やかに外部利用の概要及び終了した旨を、別紙様式第7「外部利用終了報告書」に記載の上、機構に提出するものとします。外部利用者が、第8条の規定により外部利用の許可を取り消された場合若しくは外部利用を中止された場合又は第10条第3項の規定により外部利用の取りやめを行った場合も同様とします。

（外部利用の成果の報告）

第19条 研究連携型の外部利用者は、外部利用終了後、速やかに外部利用の成果の概要を、別紙様式第8「成果報告書」に記載の上、機構に提出するものとします。外部利用者が、第8条の規定により外部利用の許可を取り消された場合若しくは外部利用を中止された場合又は第10条第3項の規定により外部利用の取りやめを行った場合も同様とします。

（外部利用の成果の取扱い）

第20条 外部利用者は、外部利用の成果を発表するときは、当該外部利用の成果であることを記載するものとします。

- 2 外部利用者は、外部利用の成果等に関する報道発表を行おうとするときは、あらかじめ機構と協議するものとします。
- 3 機構は、外部利用の成果を公表することができるものとし、公表の内容、時期、方法等については、外部利用者と協議の上、決定するものとします。ただし、機構と外部利用者との間で協議の上、公表しないこともできるものとします。

（知的財産権）

第21条 外部利用の成果として外部利用者が単独で得た知的財産権は、当該外部利用者に帰属するものとします。

- 2 外部利用の成果として得られた機構と外部利用者の共有に係る知的財産権は、その取扱いについて機構と当該外部利用者との間で協議して定めるものとします。
- 3 外部利用の成果として外部利用者が単独で得た知的財産権に関して外部利用者と第三者との間で紛争が生じた場合には、当該外部利用者の責任において全て解決するものとします。

（外部利用者の遵守事項）

第22条 外部利用者は、本約款に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。

- 一 第6条第1項の各号
- 二 第8条第1項の各号に該当しないこと

### 三 その他機構が管理運営上必要と認める事項

#### (パーソナルデータの取扱い)

第23条 外部利用者は、外部利用においてパーソナルデータ（個人に関する情報をいう。以下本条において同じ。）を取り扱う必要がある場合には、あらかじめ機構と協議するものとします。

2 外部利用者は、外部利用により取得したパーソナルデータを善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとし、必要に応じて、別途機構との間でパーソナルデータの取扱いに関する契約書を締結するものとします。

#### (秘密情報の扱い)

第24条 機構又は外部利用者は、相手方に秘密情報を開示する場合又は相手方から秘密情報の開示を受ける場合には、別途秘密保持契約を締結するものとします。

2 外部利用者は、外部利用により機構又は第三者の秘密情報その他の公にしていな情報に接した場合、これを他の者に開示しないものとし、及びこれが漏えいしないよう必要な措置を講ずるものとします。

3 機構は、外部利用者の秘密情報に接したときは、これを第三者に開示しないものとします。

#### (損害の賠償)

第25条 外部利用者は、故意又は過失によって機構の施設等を破損又は滅失等させたとき若しくは外部利用により接した機構又は他の外部利用者等の秘密情報等を第三者に開示又は漏えいし、機構に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

2 機構は、第8条の規定により外部利用の許可を取り消し、若しくは外部利用を中止させた場合又は第10条第3項の規定により外部利用の取りやめを許可した場合において、機構の施設等に損害があるときは、当該外部利用者に損害賠償請求をすることができるものとします。

#### (保全義務)

第26条 外部利用者は、善良な管理者の注意をもって施設等の維持保全をしなければならないものとします。

2 前項の維持保全のため通常必要とする修繕費その他の経費は、全て外部利用者の負担とするものとします。

#### (原状回復義務)

第27条 外部利用者は、外部利用を終了したときは、機構の指示に従って施設等を原状に回復するものとします。この場合において、原状回復に当たり通常必要と認められる費用については、外部利用者が負担するものとします。

2 外部利用者は、機構の財産を破損又は滅失等させたときは、外部利用者の費用負担をもって原状に回復するものとします。

3 原状回復に当たり、費用負担に疑義が生じた場合は、機構と外部利用者との間で協議するものとします。

#### (反社会的勢力の排除)

第28条 外部利用者は、外部利用の許可時及び将来にわたって次の各号に掲げる事項を機構に対し表明しかつ保証するものとします。

- 一 自ら又は自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと、及び反社会的勢力と一切の関係を持たないこと。
- 二 反社会的勢力に自己の名義を利用して外部利用を行うものでないこと。
- 三 自ら又は第三者を利用して次の行為をしないこと。
  - （１） 機構に対する威圧的な言動又は暴力を用いる行為
  - （２） 偽計又は威力を用いて機構の業務を妨害し、又は信用をき損する行為  
（機構の免責事項）

第29条 機構は、外部利用により外部利用者又は第三者に発生した損害について、いかなる責任も負わず、損害賠償及び補償は行わないものとします。

- 2 機構は、施設等の故障、不具合及び瑕疵等により生じた外部利用者及び第三者の損害について、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わないものとします。
- 3 機構は、外部利用者が当該外部利用によって第三者に損害を与えた場合には、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わないものとします。
- 4 機構は、第6条第3項又は第4項の規定に基づく外部利用日の変更又は振替えによって外部利用者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責任を負わないものとします。
- 5 機構は、第8条の規定に基づく外部利用の許可の取消し若しくは外部利用の中止又は第10条第3項の規定に基づく外部利用の取りやめの許可によって外部利用者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責任を負わないものとします。
- 6 機構は、第11条の規定に基づく外部利用の休止又は制約によって外部利用者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責任を負わないものとします。
- 7 機構は、外部利用者が持ち込んだ機器等の滅失又は毀損について、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わないものとします。
- 8 機構は、外部利用者の外部利用、外部利用の成果又は当該成果を用いた外部利用者の行為が第三者の権利を侵害するとして請求がなされた場合には、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わず、外部利用者が自らの費用と責任により解決するものとします。  
（疑義への対応）

第30条 外部利用について、本約款に定めのない事項及び本約款に定める事項について疑義が生じたときは、機構と外部利用者との間で協議の上、解決するものとします。



## 別表

### 外部利用に供する対象施設等の構成及び外部利用負担金単価

外部利用に供する対象施設等である先端 I C T デバイスラボ施設の施設等については、以下のとおりとします。

#### ○フォトニックデバイスラボ

「フォトニックデバイスラボ」には、空気清浄度クラス 1 0, 0 0 0 及びクラス 1 0 0 のクリーンルーム環境の中に様々なプロセス装置が設置されているクリーンルームがあり、半導体レーザや光変調器などの光デバイスを一通り試作することが可能となっています。

外部利用で実施することが可能なデバイス製造プロセスモデルとして、(1) から (1 0) の 1 1 のモデルを用意しています。

#### ○ミリ波研究棟

「ミリ波研究棟」には、クリーンルームを含む複数の実験室、及び、それらの実験環境を支える機械設備が設置されており、半導体プロセス、基板加工、材料評価、高周波評価など、先端 I C T デバイスの作製から評価まで一貫して行うことが可能となっています。

外部利用で実施することが可能なデバイス製造プロセスモデルとして、次々頁以降の (1 1) から (1 3) の 3 のモデルを用意しています。

#### ○神戸研究所

「神戸研究所」には、新クリーンルーム及び第 1 研究棟内に、スパッタリング装置等が設置されており、超伝導ナノワイアデバイスの作成が可能です。次々頁以降の (1 4) から (2 0) の 1 2 のモデルを用意しています。

外部利用に供する施設等の構成及びこれらの施設等一式を外部利用した際の外部利用負担金につき、それぞれ次々頁以降のとおり、(1) から (2 0) のデバイス製造プロセスモデルごとに設定しています。

外部利用負担金は、以下の費用から構成されています。

(1) 施設等の利用に係る費用：各デバイス製造プロセスモデルにおいて、必要となる施設等一式を利用するための費用です。

(2) 技術支援に係る費用：

各デバイス製造プロセスモデルにおいて、必要となる機構職員の技術支援に係る費用であり、以下の費用で構成されます。

(a) 施設等利用支援費：施設等を利用する際に、機構職員から事前説明等の支援を行う際に必要となる費用です。

(b) 技術・ノウハウ費：施設等を利用する際に、機構が用意した施設等ごとのレシピを使用する際に必要となる費用です。

デバイス製造プロセスモデルについては、以下のとおり取り扱うものとします。

(1) 外部利用申請を行うに当たっては、複数のデバイス製造プロセスモデルを選択できるものとします。

(2) 上記(1)の場合、同日又は同期間で複数のデバイス製造プロセスモデルを実施することができるものとします。

(3) ただし、同日又は同期間で複数のデバイス製造プロセスモデルを実施した場合であっても、外部利用負担金は、別表に基づきそれぞれのデバイス製造プロセスモデルごとにかかった日数（神戸研究所についてはプロセスモデル数）に基づき算定の上、一括で支払うようにしてください。

(1) デバイス製造プロセスモデル1： Ridge LD加工技術

半導体レーザ結晶を基に、リッジ導波路型ファブリペローレーザ構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/日)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	プラズマ ドライクリーニング 装置	53,000	6,000	20,000	27,000	3,000	10,000	14,000	2,000	5,000
2	プラズマCVD装置									
3	プラズマ ドライエッチング 装置									
4	真空排気用ポンプ									
5	基板ステージ 温度制御機構									
6	基板静電 チャック機構									
7	触針式段差測定器									
8	電子ビーム 蒸着装置 1									

9	電子ビーム 蒸着装置 2									
10	シンタ炉									
11	スピコータ (1H-DX2型 標準仕様本体)									
12	スピコータ (EB描画用)									
13	酸・アルカリ用 ドラフトチャンバー									
14	有機用ドラフト チャンバー									
15	微細マスクアライナ (高精細マスク アライナ)									
16	微細加工システム									
17	光干渉式自動膜厚 測定器									
18	オリンパス顕微鏡用 デジタルカメラ									
19	LDテスター									
20	ブレーキング装置									
21	プログラマブル オーブン									

(2) デバイス製造プロセスモデル2：Broad-area LD加工技術

半導体レーザ結晶を基に、ブロードエリアレーザ構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/日)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費		施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費		施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費
1	プラズマ ドライクリーニング 装置	48,000	4,000	13,000	24,000	2,000	7,000	12,000	1,000	4,000
2	プラズマCVD装置									
3	電子ビーム 蒸着装置 1									
4	電子ビーム 蒸着装置 2									
5	シンタ炉									
6	スピンドータ (1H-DX2型 標準仕様本体)									
7	スピンドータ (EB描画用)									

8	酸・アルカリ用 ドラフトチャンバー									
9	有機用ドラフト チャンバー									
10	微細マスクアライナ (高精細マスク アライナ)									
11	光干渉式自動膜厚 測定器									
12	オリンパス顕微鏡用 デジタルカメラ									
13	LDテスター									
14	ブレーキング装置									

(3) デバイス製造プロセスモデル3：LED加工技術

半導体PN接合結晶を基に、面発光LED構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/日)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	プラズマCVD装置	50,000	5,000	18,000	25,000	3,000	9,000	13,000	2,000	5,000
2	プラズマドライエッチング装置									
3	真空排気用ポンプ									
4	基板ステージ温度制御機構									
5	基板静電チャック機構									
6	触針式段差測定器									
7	電子ビーム蒸着装置1									
8	電子ビーム蒸着装置2									
9	シンタ炉									

10	スピコータ (1H-DX2型 標準仕様本体)									
11	スピコータ (EB描画用)									
12	酸・アルカリ用 ドラフトチャンバー									
13	有機用ドラフト チャンバー									
14	微細マスクアライナ (高精細マスク アライナ)									
15	光干渉式自動膜厚 測定器									
16	オリンパス顕微鏡用 デジタルカメラ									
17	LDテスター									
18	ブレーキング装置									



(4)－a デバイス製造プロセスモデル4 a：光導波路デバイス加工技術（半導体）

露光パターンニングとエッチングにより、半導体光パッシブ導波路構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価（円／日）								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	プラズマCVD装置	55,000	5,000	16,000	28,000	3,000	8,000	14,000	2,000	4,000
2	ICPエッチング装置									
3	触針式段差測定器									
4	スピンドータ （1H-DX2型 標準仕様本体）									
5	スピンドータ （EB描画用）									
6	酸・アルカリ用 ドラフトチャンバー									
7	有機用ドラフト チャンバー									
8	微細マスクアライナ （高精細マスク アライナ）									

9	微細加工システム									
10	オリンパス顕微鏡用 デジタルカメラ									
11	ブレーキング装置									

(4)－b デバイス製造プロセスモデル4 b： 光導波路デバイス加工技術（誘電体）

露光パターンニングとエッチングにより、誘電体光パッシブ導波路構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価（円／日）								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	プラズマCVD装置	53,000	8,000	28,000	27,000	4,000	14,000	14,000	2,000	7,000
2	プラズマドライエッチング装置									
3	真空排気用ポンプ									
4	基板ステージ温度制御機構									
5	基板静電チャック機構									
6	触針式段差測定器									
7	スピコータ（1H-DX2型標準仕様本体）									
8	スピコータ（EB描画用）									

9	酸・アルカリ用 ドラフトチャンバー									
10	有機用ドラフト チャンバー									
11	微細マスクアライナ (高精細マスク アライナ)									
12	オリンパス顕微鏡用 デジタルカメラ									
13	ブレーキング装置									
14	拡散炉 (WE T酸化装置)									

(5) デバイス製造プロセスモデル5：PD加工技術

半導体PN接合結晶を基に、面受光型PD構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/日)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	プラズマCVD装置	50,000	5,000	18,000	25,000	3,000	9,000	13,000	2,000	5,000
2	プラズマドライエッチング装置									
3	真空排気用ポンプ									
4	基板ステージ温度制御機構									
5	基板静電チャック機構									
6	触針式段差測定器									
7	電子ビーム蒸着装置1									
8	電子ビーム蒸着装置2									
9	シンタ炉									

10	スピコータ (1H-DX2型 標準仕様本体)									
11	スピコータ (EB描画用)									
12	酸・アルカリ用 ドラフトチャンバー									
13	有機用ドラフト チャンバー									
14	微細マスクアライナ (高精細マスク アライナ)									
15	光干渉式自動膜厚 測定器									
16	オリンパス顕微鏡用 デジタルカメラ									
17	LDテスター									
18	ブレーキング装置									

(6) デバイス製造プロセスモデル6：LN変調器作製技術

拡散導波路型LN光変調器の基礎デバイス構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/日)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	プラズマ ドライエッチング 装置	46,000	4,000	15,000	23,000	2,000	8,000	12,000	1,000	4,000
2	真空排気用ポンプ									
3	基板ステージ 温度制御機構									
4	基板静電 チャック機構									
5	電子ビーム 蒸着装置1									
6	スピンドータ (1H-DX2型 標準仕様本体)									
7	スピンドータ (EB描画用)									

8	酸・アルカリ用 ドラフトチャンバー									
9	有機用ドラフト チャンバー									
10	微細マスクアライナ (高精細マスク アライナ)									
11	オリンパス顕微鏡用 デジタルカメラ									
12	拡散炉 (WE T酸化装置)									
13	ダイシングソー装置									



(7) デバイス製造プロセスモデル7： コーティング技術

母材の表面に屈折率を変調した誘電体多層膜構造や金属薄膜を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/日)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費		施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費		施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費
1	電子ビーム 蒸着装置 1	52,000	5,000	17,000	26,000	3,000	9,000	13,000	2,000	5,000
2	RFスパッタ装置									
3	分光光度計									

(8) デバイス製造プロセスモデル8：電極パターニング技術

任意のウェハへの電極蒸着、パターニング技術に関するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/日)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	電子ビーム蒸着装置2	46,000	3,000	11,000	23,000	2,000	6,000	12,000	1,000	3,000
2	有機用ドラフトチャンバー									
3	高精細露光用光学システム									
4	オリンパス顕微鏡用デジタルカメラ									

(9) デバイス製造プロセスモデル9： フォトルミネッセンス技術

低温における材料の光学特性を評価するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/日)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費		施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費		施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費
1	高出力10W グリーンレーザ	51,000	4,000	16,000	26,000	2,000	8,000	13,000	1,000	4,000
2	フォトルミネッセンス 測定装置									

(10) デバイス製造プロセスモデル10：表面微細加工評価技術

原子間力顕微鏡、電子顕微鏡による表面観察に関するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/日)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費		施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費		施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費
1	微細加工システム	75,000	8,000	31,000	38,000	4,000	16,000	19,000	2,000	8,000
2	原子間力顕微鏡									

(11) デバイス製造プロセスモデル11：全帯域テラヘルツ時間領域分光評価技術

標準帯域から広帯域まで全ての帯域のテラヘルツ時間領域の分光を行い、材料等を高周波評価するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/日)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	小型高速テラヘルツ時間領域分光装置 (標準帯域版分光装置)	23,000	4,000	13,000	12,000	2,000	7,000	6,000	1,000	4,000
2	小型高速テラヘルツ時間領域分光装置 (広帯域版分光装置)									

(12) デバイス製造プロセスモデル12：標準帯域テラヘルツ時間領域分光評価技術

標準帯域のテラヘルツ時間領域の分光を行い、材料等を高周波評価するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/日)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	小型高速テラヘルツ時間領域分光装置 (標準帯域版分光装置)	18,000	3,000	10,000	9,000	2,000	5,000	5,000	1,000	3,000

(13) デバイス製造プロセスモデル13： 広帯域テラヘルツ時間領域分光評価技術

広帯域のテラヘルツ時間領域の分光を行い、材料等を高周波評価するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/日)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	小型高速テラヘルツ時間領域分光装置 (広帯域版分光装置)	19,000	3,000	10,000	10,000	2,000	5,000	5,000	1,000	3,000

(14) デバイス製造プロセスモデル14：超伝導薄膜成膜プロセス

主に基板上にスパッタリング装置により超伝導薄膜を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/モデル)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費		施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費		施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費
1	スパッタリング装置	9,000	2,000	9,000	5,000	1,000	5,000	3,000	1,000	3,000
2	超音波洗浄機 1-2161-04									



(15)ー a デバイス製造プロセスモデル15 a : 金属薄膜リフトオフプロセス1

i線ステップと金属薄膜蒸着を用いたリフトオフプロセスにより金属薄膜構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/モデル)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	i線ステップ装置	46,000	4,000	14,000	23,000	2,000	7,000	12,000	1,000	4,000
2	自動レジスト塗布装置									
3	真空蒸着装置									
4	超音波洗浄機 1-2161-04									

(15)ーb デバイス製造プロセスモデル15b：金属薄膜リフトオフプロセス2

アライメントシステムと金属薄膜蒸着を用いたリフトオフプロセスにより金属薄膜構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/モデル)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	自動レジスト塗布装置	14,000	4,000	14,000	7,000	2,000	7,000	4,000	1,000	4,000
2	真空蒸着装置									
3	超音波洗浄機 1-2161-04									
4	近赤外対応アライメントシステム									

(16) デバイス製造プロセスモデル16： ナノパターン描画・加工プロセス

電子ビーム及びエッチング装置と有機洗浄装置を用いたナノパターンを作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/モデル)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	超高精細高精度電子ビーム描画装置	25,000	5,000	21,000	13,000	3,000	11,000	7,000	2,000	6,000
2	自動レジスト塗布装置									
3	超音波洗浄機 1-2161-04									
4	リアクティブイオンエッチング装置									
5	ウェハ有機洗浄装置									

(17)ー a デバイス製造プロセスモデル17 a : 超伝導薄膜成膜リフトオフプロセス1

i線ステッパとスパッタ装置を用いたリフトオフプロセスにより超伝導薄膜構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/モデル)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	スパッタリング装置	43,000	4,000	14,000	22,000	2,000	7,000	11,000	1,000	4,000
2	i線ステッパ装置									
3	自動レジスト塗布装置									
4	超音波洗浄機 1-2161-04									

(17)ーb デバイス製造プロセスモデル17b：超伝導薄膜成膜リフトオフプロセス2

アライメントシステムとスパッタ装置を用いたリフトオフプロセスにより超伝導薄膜構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/モデル)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用		施設等の 利用に係る 費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費		施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費		施設等利用 支援費	技術・ ノウハウ費
1	自動レジスト塗布装置	12,000	3,000	12,000	6,000	2,000	6,000	3,000	1,000	3,000
2	スパッタリング装置									
3	超音波洗浄機 1-2161-04									
4	近赤外対応アライメン トシステム									

(18)ー a デバイス製造プロセスモデル18 a : マイクロパターン加工プロセス1

i線ステッパ装置とエッチング装置を用いてマイクロパターン構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/モデル)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	i線ステッパ装置	39,000	3,000	8,000	20,000	2,000	4,000	10,000	1,000	2,000
2	自動レジスト塗布装置									
3	超音波洗浄機 1-2161-04									
4	リアクティブイオンエッチング装置									

(18)ーb デバイス製造プロセスモデル18b： マイクロパターン加工プロセス2

アライメントシステムとエッチング装置を用いてマイクロパターン構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/モデル)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	自動レジスト塗布装置	11,000	3,000	10,000	6,000	2,000	5,000	3,000	1,000	3,000
2	リアクティブイオンエッチング装置									
3	超音波洗浄機 1-2161-04									
4	近赤外対応アライメントシステム									

(19)ー a デバイス製造プロセスモデル19 a : 誘電体・金属薄膜リフトオフプロセス1

i線ステップ装置と蒸着装置を用いたリフトオフプロセスにより誘電体／金属薄膜構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円／モデル)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	i線ステップ装置	51,000	5,000	20,000	26,000	3,000	10,000	13,000	2,000	5,000
2	自動レジスト塗布装置									
3	真空蒸着装置									
4	超音波洗浄機 1-2161-04									
5	真空蒸着装置									



(19)ーb デバイス製造プロセスモデル19b：誘電体・金属薄膜リフトオフプロセス2

アライメントシステムと蒸着装置を用いたリフトオフプロセスにより誘電体／金属薄膜構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円／モデル)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	自動レジスト塗布装置	17,000	5,000	20,000	9,000	3,000	10,000	5,000	2,000	5,000
2	真空蒸着装置									
3	超音波洗浄機 1-2161-04									
4	近赤外対応アライメントシステム									
5	真空蒸着装置									

(20)ー a デバイス製造プロセスモデル20 a : ディープエッチングプロセス1

i線ステップ及びディープエッチング装置を用いたSi深堀りパターン構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/モデル)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	i線ステップ装置	50,000	4,000	14,000	25,000	2,000	7,000	13,000	1,000	4,000
2	自動レジスト塗布装置									
3	超音波洗浄機 1-2161-04									
4	ディープエッチング装置									

(20)ーb デバイス製造プロセスモデル20b：ディープエッチングプロセス2

アライメントシステムとディープエッチング装置を用いてSi深堀りパターン構造を作製するプロセスモデルです。

番号	対象施設等の構成	外部利用負担金単価 (円/モデル)								
		基本単価			第15条第1項又は第2項の規定による減額後の単価			第15条第1項及び第2項の規定による減額後の単価		
		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用		施設等の利用に係る費用	技術支援に係る費用	
			施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費		施設等利用支援費	技術・ノウハウ費
1	近赤外対応アライメントシステム	22,000	4,000	14,000	11,000	2,000	7,000	6,000	1,000	4,000
2	自動レジスト塗布装置									
3	超音波洗浄機 1-2161-04									
4	ディープエッチング装置									

外部利用申請書

年 月 日

国立研究開発法人情報通信研究機構

外部利用責任者

総合テストベッド研究開発推進センター長 殿

住所

機関名

代表者役職

代表者氏名

国立研究開発法人情報通信研究機構の「先端ICTデバイスラボ施設外部利用約款」に基づき、下記のとおり外部利用を申請します。

なお、外部利用にあたっては、上記の約款において定められた全ての事項を遵守します。

記

<p>1. 外部利用を行う場所 (外部利用を行う場所に☑を入れてください。)</p>	<p><input type="checkbox"/> フォトニックデバイスラボ <input type="checkbox"/> ミリ波研究棟 <input type="checkbox"/> 神戸研究所</p>
<p>2. デバイス製造プロセスモデル (外部利用に係るデバイス製造プロセスモデルを全て選択してください。)</p>	<p><input type="checkbox"/> (1) デバイス製造プロセスモデル1 <input type="checkbox"/> (2) デバイス製造プロセスモデル2 <input type="checkbox"/> (3) デバイス製造プロセスモデル3 <input type="checkbox"/> (4)－a デバイス製造プロセスモデル4 a <input type="checkbox"/> (4)－b デバイス製造プロセスモデル4 b <input type="checkbox"/> (5) デバイス製造プロセスモデル5 <input type="checkbox"/> (6) デバイス製造プロセスモデル6 <input type="checkbox"/> (7) デバイス製造プロセスモデル7 <input type="checkbox"/> (8) デバイス製造プロセスモデル8 <input type="checkbox"/> (9) デバイス製造プロセスモデル9 <input type="checkbox"/> (10) デバイス製造プロセスモデル10 <input type="checkbox"/> (11) デバイス製造プロセスモデル11 <input type="checkbox"/> (12) デバイス製造プロセスモデル12 <input type="checkbox"/> (13) デバイス製造プロセスモデル13 <input type="checkbox"/> (14) デバイス製造プロセスモデル14</p>

	<input type="checkbox"/> (15)–a デバイス製造プロセスモデル15a <input type="checkbox"/> (15)–b デバイス製造プロセスモデル15b <input type="checkbox"/> (16) デバイス製造プロセスモデル16 <input type="checkbox"/> (17)–a デバイス製造プロセスモデル17a <input type="checkbox"/> (17)–b デバイス製造プロセスモデル17b <input type="checkbox"/> (18)–a デバイス製造プロセスモデル18a <input type="checkbox"/> (18)–b デバイス製造プロセスモデル18b <input type="checkbox"/> (19)–a デバイス製造プロセスモデル19a <input type="checkbox"/> (19)–b デバイス製造プロセスモデル19b <input type="checkbox"/> (20)–a デバイス製造プロセスモデル20a <input type="checkbox"/> (20)–b デバイス製造プロセスモデル20b
3. 外部利用を行う機関名 (外部利用に参加する全ての機関名を記入してください。)	
4. 外部利用の目的	
5. 利用形態 (該当する形式に <input checked="" type="checkbox"/> を入れてください。)	<input type="checkbox"/> 研究連携型 <input type="checkbox"/> 成果活用・施設等供用型
6. 外部利用の日又は期間 (「2. デバイス製造プロセスモデル」で選択したデバイス製造プロセスモデルごとに記入してください。)	選択したデバイス製造プロセスモデル： 外部利用の日又は期間：  選択したデバイス製造プロセスモデル： 外部利用の日又は期間：
7. 持ち込み実験機器、情報通信機器、化学物質等の有無	有 ・ 無  「有」の場合は、別紙様式第2「外部利用計画書」に詳細を記載してください。
8. 外部利用の人数	
9. その他特記事項	

(記入に当たっての注意事項)

1. 「2. デバイス製造プロセスモデル」については、本約款の別表の中から複数のデバイス製造プロセスモデルを選択することが可能です。
2. 「3. 外部利用を行う機関名」は、略称ではなく正式名称を記入してください。
3. 「6. 外部利用の日又は期間」については、「2. デバイス製造プロセスモデル」ごとに記入してください。記入する欄が足りない場合は、適宜追加の上、記入してください。複数のデバイス製造プロセスモデルを同日又は同期間で行うことも可能です。
4. 本約款第15条（外部利用負担金の減額）第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合には、そのことが分かる情報を「9. その他特記事項」に記入してください。その他、同項の規定に該当するかどうかを判断するために必要な書類を提出していただくことがあります。

別紙様式第2 (第5条関係)

外部利用計画書

申請年月日		年 月 日	
計画担当者	(氏 名)		(職名)
所属機関	(名 称)		
	(住 所)	〒	
		(電子メールアドレス)	(電話番号)

下記のとおり、外部利用計画書を申請いたします。

記

1. 計画名：			
2. 外部利用で行う実験内容の詳細：			
3. 期 間：		～	

4. 外部利用者の構成員一覧：（構成員が多い場合は別紙とすること）

	氏 名	所属（学生の方は学部・学年も）	機器・薬品等の使用経歴
1	※以下余白		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

学部生等の先端ICTデバイスラボ施設の施設等を利用した経験が十分でない場合:「実験室・測定室では院生もしくはNICT研究者と行動を共にします。」の一文を記載のこと。

5. 持ち込み予定の実験機器、情報通信機器（パーソナルコンピュータ、携帯端末等）、化学物質等の名称、数量、利用目的、消費電力等

1	名称（型番）： 数量： 利用目的： 消費電力：	2	名称（型番）： 数量： 利用目的： 消費電力：
3	名称（型番）： 数量： 利用目的： 消費電力：	4	名称（型番）： 数量： 利用目的： 消費電力：
5	名称（型番）： 数量： 利用目的： 消費電力：	6	名称（型番）： 数量： 利用目的： 消費電力：

総消費電力（各消費電力が不明な場合）：



(記入に当たっての注意事項)

「5. 持ち込み予定の実験機器、情報通信機器（パーソナルコンピュータ、携帯端末等）、化学物質等の名称、数量、利用目的、消費電力等」については、以下のとおり記入してください。

- (1) 機器等ごとに数量及び利用目的を記入してください。
- (2) 機器等で型番がわかるものは、それぞれの機器等の型番も記入してください。
- (3) 電力を使用する機器等の場合には、機器等ごとに消費電力を記入してください。ただし、機器等ごとの電力がわからない場合には、全ての機器等の総消費電力を記入してください。
- (4) 記入する欄が足りない場合は、適宜追加の上、記入してください。

## 6. 機構が行う研究開発及び施設等の運用への寄与内容（研究連携型の場合のみ）

「先端ICTデバイスラボ施設外部利用約款」第3条第2項第1号に掲げる、外部利用で得られる施設等の機能・性能の評価に資する実験データ又は外部利用の効果を評価した結果を示す報告書について、どのようなものが提供可能であるか、概要を記載してください。

## 7. 今後の情報通信研究機構との共同研究契約の予定

有 ・ 無

「有」の場合には、以下をご記入ください。

(1) 共同研究契約締結予定日	
(2) 共同研究における情報通信研究機構における研究担当者	
氏名	
所属・役職	

## 8. 今後の外部利用のスケジュール

当機構において、今後の施設等の外部利用の状況を把握するため、今回の外部利用以降、年度内又は次年度に再度先端ICTデバイスラボ施設の施設等の外部利用を予定している場合には、外部利用を行うスケジュールにつき、わかる範囲で記入してください。

--

外部利用許可通知書

情通機○第 号  
年 月 日

外部利用者 (機関)  
(代表者) 殿

国立研究開発法人情報通信研究機構  
外部利用責任者  
総合テストベッド研究開発推進センター長

〇〇年〇〇月〇〇日付けで申請のあった外部利用については、下記のとおり許可したので通知します。

なお、外部利用にあたっては、国立研究開発法人情報通信研究機構の「先端ICTデバイスラボ施設外部利用約款」に定める事項を遵守してください。

記

1. 外部利用を行う場所 (外部利用を行う場所に☑を入れてください。)	<input type="checkbox"/> フォトニックデバイスラボ <input type="checkbox"/> ミリ波研究棟 <input type="checkbox"/> 神戸研究所
2. デバイス製造プロセスモデル	
3. 外部利用を行う機関名	
4. 外部利用の目的	
5. 利用形態	<input type="checkbox"/> 研究連携型 ・ <input type="checkbox"/> 成果活用・施設等供用型
6. 外部利用の日又は期間	
7. 持ち込み実験機器、情報通信機器、化学物質等の名称、数量、利用目的、消費電力等	<input type="checkbox"/> 外部利用計画書どおり ・ <input type="checkbox"/> 変更あり 「変更あり」の場合の変更点は、別紙のとおり。
8. 外部利用の人数	
9. 外部利用に当たっての条件等	有 ・ 無
10. 外部利用負担金額	

利用規則の概要及び同意書

先端ICTデバイスラボ ラボ長

【利用規則の概要】

情報通信研究機構（NICT）先端ICTデバイスラボのフォトニックデバイスラボ、ミリ波研究棟又は神戸研究所の利用に当たっては、NICTの定める安全衛生関係規程とラボ運営連絡会等が定める諸規則を遵守するとともに、以下の事項を確実に実施すること。

1. 利用日毎に当日の作業計画書を提出し、終了後は作業報告書を提出すること。
2. 緊急時には実験作業を中止し、ラボ長、又はラボスタッフなどの指示に従うこと。

また、以下に留意すること。

1. 作業の安全に関わる事柄および実験方法については、ラボ長の承認を受けてください。
2. 実験データなどの技術資料、NICT内で得た技術情報はラボ長の許可なく持ち出すことを禁じます。
3. 学部生等の先端ICTデバイスラボ施設の施設等を利用した経験が十分でない者のみの行動は原則禁止です。

---

【同意書】

国立研究開発法人情報通信研究機構  
先端ICTデバイスラボ ラボ長 殿

ラボ実験設備利用に関するNICT規程ならびに諸規則のほか、上記事項全般に同意し、これらを遵守いたします。

年 月 日

所属機関名	
所属部署・役職 又は 学部等・学年（学生の場合）	
本人氏名	
所属長 又は 指導教官（学生の場合）	

別紙様式第5 (第10条関係)

外部利用の内容変更・取りやめ申請書

年 月 日

国立研究開発法人情報通信研究機構

外部利用責任者

総合テストベッド研究開発推進センター長 殿

住所

機関名

代表者役職

代表者氏名

情通機○第 号○○年○○月○○日付けで許可された事項について変更したいので、下記のとおり申請します。

記

1. 申請種別	<input type="checkbox"/> 外部利用の日又は期間の変更 <input type="checkbox"/> 持ち込み実験機器、情報通信機器、化学物質等の名称、数量、利用目的、消費電力等の変更 <input type="checkbox"/> 外部利用の人数の変更 <input type="checkbox"/> 外部利用計画書の変更 <input type="checkbox"/> 外部利用の取りやめ
2. 内容変更又は取りやめの理由	
3. 外部利用許可書からの変更概要	
4. 外部利用計画書の変更項目	

情通機○第 号  
 ADICTDL-○○-○○○○  
 年 月 日

請 求 書

外部利用者 (機関)  
 (代表者) 殿

〒184-8795  
 東京都小金井市貫井北町4-2-1  
 国立研究開発法人情報通信研究機構

経理担当 財務部長 ○○ ○○

下記のとおりご請求申し上げます。

ご請求金額 ○○○円

先端ICTデバイスラボ施設 外部利用負担金として

請求明細

(1) フォトニックデバイスラボ・ミリ波研究棟を利用する場合

項目	単価(円/日)	利用日数	利用期間	小計
小計				
消費税				
合計				

(2) 神戸研究所を利用する場合

項目	単価(円/モデル)	利用期間	小計

小計			
消費税			
合計			

納付期限：〇〇年〇〇月〇〇日まで

お支払いは下記口座にお振込み願います。

三菱UFJ銀行 国分寺支店 普通 1525560

国立研究開発法人情報通信研究機構

なお、振込手数料は貴殿にてご負担ください。

外部利用終了報告書

年 月 日

国立研究開発法人情報通信研究機構

外部利用責任者

総合テストベッド研究開発推進センター長 殿

住所

機関名

代表者役職

代表者氏名

情通機○第 号○○年○○月○○日付けで許可された施設等の外部利用を終了しましたので、下記のとおり報告します。

記

<p>1. 外部利用を行う場所 (外部利用を行う場所に☑を入れてください。)</p>	<p><input type="checkbox"/> フォトニックデバイスラボ  <input type="checkbox"/> ミリ波研究棟  <input type="checkbox"/> 神戸研究所</p>
<p>2. デバイス製造プロセスモデル (外部利用に係るデバイス製造プロセスモデルを全て選択してください。)</p>	<p><input type="checkbox"/> (1) デバイス製造プロセスモデル1  <input type="checkbox"/> (2) デバイス製造プロセスモデル2  <input type="checkbox"/> (3) デバイス製造プロセスモデル3  <input type="checkbox"/> (4)－a デバイス製造プロセスモデル4 a  <input type="checkbox"/> (4)－b デバイス製造プロセスモデル4 b  <input type="checkbox"/> (5) デバイス製造プロセスモデル5  <input type="checkbox"/> (6) デバイス製造プロセスモデル6  <input type="checkbox"/> (7) デバイス製造プロセスモデル7  <input type="checkbox"/> (8) デバイス製造プロセスモデル8  <input type="checkbox"/> (9) デバイス製造プロセスモデル9  <input type="checkbox"/> (10) デバイス製造プロセスモデル10  <input type="checkbox"/> (11) デバイス製造プロセスモデル11  <input type="checkbox"/> (12) デバイス製造プロセスモデル12  <input type="checkbox"/> (13) デバイス製造プロセスモデル13  <input type="checkbox"/> (14) デバイス製造プロセスモデル14  <input type="checkbox"/> (15)－a デバイス製造プロセスモデル15 a</p>



	<input type="checkbox"/> (15)–b デバイス製造プロセスモデル15 b <input type="checkbox"/> (16) デバイス製造プロセスモデル16 <input type="checkbox"/> (17)–a デバイス製造プロセスモデル17 a <input type="checkbox"/> (17)–b デバイス製造プロセスモデル17 b <input type="checkbox"/> (18)–a デバイス製造プロセスモデル18 a <input type="checkbox"/> (18)–b デバイス製造プロセスモデル18 b <input type="checkbox"/> (19)–a デバイス製造プロセスモデル19 a <input type="checkbox"/> (19)–b デバイス製造プロセスモデル19 b <input type="checkbox"/> (20)–a デバイス製造プロセスモデル20 a <input type="checkbox"/> (20)–b デバイス製造プロセスモデル20 b
3. 外部利用を行った機関名 (外部利用に参加した全ての機関名 を記入してください。)	
4. 外部利用の目的	
5. 外部利用の日又は期間 (「2. デバイス製造プロセスモデル」で選択したデバイス製造プロセスモデルごとに記入してください。)	選択したデバイス製造プロセスモデル： 外部利用の日又は期間：  選択したデバイス製造プロセスモデル： 外部利用の日又は期間：
6. 持ち込み実験機器、情報通信機器、化学物質等の有無	有 ・ 無
7. 外部利用の人数	
8. 外部利用の成果の取扱い	<input type="checkbox"/> 論文・学会発表 <input type="checkbox"/> 知的財産権の出願・取得

	<input type="checkbox"/> 国際標準化・技術標準化 <input type="checkbox"/> 実用化 <input type="checkbox"/> 製品化 <input type="checkbox"/> 起業化 <input type="checkbox"/> その他 (具体的内容)
9. 外部利用の成果の公開予定	有 ・ 無 有の場合、以下を記載。 ( 年 月予定)
10. 外部利用の目的の達成度 (該当する達成度に <input checked="" type="checkbox"/> を入れてください。)	<input type="checkbox"/> 目的を十分達成できた。 <input type="checkbox"/> 目的をある程度達成できた。 <input type="checkbox"/> 目的を十分達成できなかった。
11. ご意見等 (特に外部利用の目的を十分達成できなかった場合、その理由など)	

成果報告書

提出年月日： 年 月 日

1. 外部利用を行った場所

フォトリソグラフィラボ ・ ミリ波研究棟 ・ 神戸研究所

2. 外部利用代表者

(1) 氏名	
(漢字)	
(フリガナ)	
(2) 機関名	
(日本語)	
(英語)	
(3) 所属・役職	
(日本語)	
(英語)	

### 3. デバイス製造プロセスモデル

外部利用に係るデバイス製造プロセスモデルにつき、全て記入してください。

### 4. 外部利用を行った機関名

外部利用に参加した全ての機関名を記入してください。

### 5. 外部利用者の構成員一覧

氏名	機関名	所属・役職

(記入例)

氏名	機関名	所属・役職
	〇〇大学	□□学部 △△学科 教授
	〇〇大学	□□学部 △△学科 准教授
	〇〇大学	◇◇学部 ▽▽学科 教授
	〇〇大学〇〇学部 助教授	◇◇学部 ▽▽学科 准教授
(複数機関による外部利用の場合、1行空ける)		
	〇〇株式会社	□□部 部長
	〇〇株式会社	□□部 △△課 課長

6. 外部利用の目的

7. 外部利用の日又は期間

「3. デバイス製造プロセスモデル」に記入したデバイス製造プロセスモデルごとに記入してください。

デバイス製造モデル	外部利用の日又は期間

8. 外部利用の具体的内容

## 9. 約款第3条第2項第1号及び第2号に掲げられている事項

(1) 「先端ICTデバイスラボ施設外部利用約款」第3条第2項第1号に掲げられている「外部利用で得られる施設等の機能・性能の評価に資する実験データ」を提供できる場合には、これを提供するとともに、その概要を記載してください。

(2) 「先端ICTデバイスラボ施設外部利用約款」第3条第2項第1号に掲げられている「外部利用の効果を評価した結果を示す報告書」を提供できる場合には、これを本「成果報告書」の別添として提供するとともに、その概要を記載してください。

## 10. 外部利用の成果

### (1) 外部利用の成果

外部利用の成果とその意義について、具体的に記載してください。特に「論文・学会発表」、「知的財産権の出願・取得」、「国際標準化・技術標準化」、「実用化」、「製品化」、「起業化」等の成果が出たもの（予定も含め）について、重点的に記載してください。

### (2) 外部利用の成果の今後の取扱い及び活用方策